(51) APPLICATOR

(43) 27.11.1984 (19) JP

(11) 59-208831 (A) (21) Appl. No. 58-82751

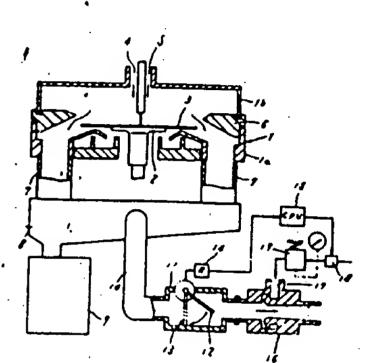
(22) 13.5.1983

(71) HITACHI OUME DENSHI K.K.(1) (72) SUSUMU NANKOU(3)

(51) Int. Cl3. H01L21,30,B05C11/08

PURPOSE: To prevent the flash-back of an application material and the inequality of film thickness by stably controlling a displacement from a treating vessel optimally.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 3 is rotatably held simultaneously to the upper surface of a spinner 2 mounted so as to be able to turn at desired speed up to high speed from low speed by a motor. A ring 6 for preventing the flashback of a resist is placed between the lower cup section 1a and upper cup section 1b of a treating vessel 1. When the resist is dropped to the central section of the wafer 3 from a nozzle 5, a resist film is formed by the revolution of the waler 3, but an exhaust is started through a discharge pipe 7, an exhaust pipe 10, etc. at the same time. The angle of rotation of a flap plate 12 in a displacement detector 11 is detected simultaneously as output resistance R'by a potentiometer 14, the correlation of the value and a displacement is arithmetically treated by a CPU15, the opening of a needle valve 18 is controlled by the CPU15, and the quantity of air fed to an exhaust generator 16 is controlled. Accordingly, the displacement from the treating vessel 1 is controlled to optimum quantity at all times.



19 日本国特許庁 (JP)

D特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-208831

①Int. Cl.³H 01 L 21/30

B 05 C 11/08

識別記号

庁内整理番号 Z 6603-5F 7639-4F

砂公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❷塗布装置

②特

願 昭58-82751

❷出

願 昭58(1983)5月13日

⑫発 明 者 南光進

青梅市藤橋3丁目3番地の2日

立青梅電子株式会社内

仍発 明 者 宮本浩一

青梅市藤橋3丁目3番地の2日

立青梅電子株式会社内

. 砂発 明 者 長友宏人

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

⑫発 明 者 前島央

小平市上水本町1450番地株式会

社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 日立青梅電子株式会社

青梅市藤橋3丁目3番地の2

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁

目6番地

⑩代 理 人 弁理士 高橋明夫

外1名

明 細 割

発明の名称 歯布装置

特許請求の範囲

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は壁布技術、特に、半導体ウェハの如き 板状体に、レジストや現像液、壁料等を回転によ る遠心力で塗布するのに適用して効果のある塗布 装置に関する。

[背景技術]

半導体ウェハにレジストや見像液を塗布する場合、スピンナ上に保持したウェハの中心部にレジスト等を滴下し、ウェハを回転させることによる 遠心力でレジストを周辺部に拡がらせて均一な膜 厚を得ることが考えられる。

その場合、ウエハの回転につれてレジストが処理容器内に飛散するので、このような飛散レジストがウエハ上にはね返って再付着すると、膜厚にむらが生じ、不良となってしまう。

そこで、レジストのはね返りを防止するため、 処理容器内のウェハの周囲に気体を供給し、その 気体の彼れによりレジストのはね返りを防止する ことが提案されうる。

しかしながら、このようなレジストのはね返り 防止用の気体としてたとえばその亜布装置が設置

特開昭59-208831(3)

なお、第 2 図は給気閉口 4 から処理容易 1 内に 供給される空気の風速 V $\{m \ne s\}$ とポテンシオ メータ 1 4 の出力抵抗 R $\{k \mid \Omega\}$ との関係を示す。 $\{ \hat{M} \mid R \} \}$

(1) 処理容器からの排気量を常に最適量に自動制 御することにより、安定した生布膜の膜厚制度が 著しく向上する。

(2). 排気量の精密な制御により、塗布材料のはね返りを防止できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を选脱しな い範囲で積々変更可能であることはいうまでもな い。

たとえば、検出器11は処理容器1内への給気量を検出するようにしてもよい。

[利用分野]

以上の税明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるレジスト生布装置に適用した場合について説明したが、

それに限定されるものではなく、たとえば、現像 液の供給や強料の塗布等、板状体の回転による速 心力を利用して塗布質を形成したり、現像処理を 行うものには広く適用できる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例によるレジスト生布 装置の一実施例を示す断面図、

第2回は空気の思速と出力抵抗との関係を示す 図である。

1・・・処理容器、2・・・スピンナ、3・・・半導体ウェハ(板状体)、4・・・給気間口、5・・・レジスト滴下ノズル、6・・・はね返り防止用のリング、7・・・排出智、8・・・排出 がイドタンク、9・・・廃液タンク、10・・・ 排気管、11・・・排気量検出器、12・・・フラップ板、13・・・ストッパ、14・・・ボテンシオメータ、15・・・CPU(制御装置)、16・・・排気発生器、17・・・孔、18ニードル弁、19・・・レギュレータ。

代理人 弁理士 高 橋 明 夫

2 N